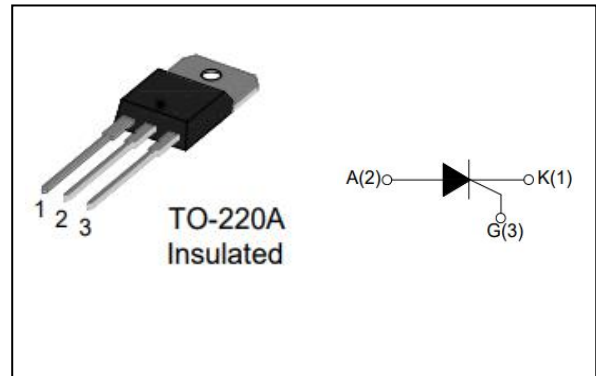


●产品特征和主要用途:

具有自主知识产权的单面挖槽技术，台面玻璃钝化工艺；背面多层金属化电极；具有较高的阻断电压和较高的温度稳定性；主要用于：吸尘器、电动工具等马达调速控制器；固态继电器；加热控制器（调温）；其它相控电路。



●极限参数

| 符号 | 参数名称 | | | 数值 | 单位 |
|-------------------|----------------------|---------|--|------------------------|------------------|
| $I_{T(RMS)}$ | 通态方均根电流 | A B | $T_c=80^{\circ}C$ $T_c=90^{\circ}C$ | 25 | A |
| I_{TSM} | 通态浪涌电流 | F=50HZ | t=20ms | 250 | A |
| I^2t | I^2t 的极限值 | tp=10ms | | 313 | A ² S |
| di/dt | 通态电流临界上升率 | | $T_j=125^{\circ}C$ | 50 | A/us |
| V_{DRM}/V_{RRM} | 断态重复峰值电压 反向重复峰值电压 | | $T_j=25^{\circ}C$ | 800 | V |
| I_{GM} | 门极峰值电流 | tp=20us | $T_j=125^{\circ}C$ | 4 | A |
| $P_{G(AV)}$ | 门极平均耗散功率 | | $T_j=125^{\circ}C$ | 1 | W |
| Tstg Tj | 储存温度 有效结温 | | | -40to+150 -40to+125 | °C |

●电特性

| 符号 | 名称和测试条件 | 象 限 | | 数值 | 单位 |
|----------------------|--|-----|-----|-----------|------|
| I_{GT} | 触发电流 $V_D=12V$ $R_L=100\Omega$ | I | MAX | ≤ 40 | mA |
| V_{GT} | 触发电压 | | MAX | 1.5 | V |
| V_{GD} | 不触发电压 $T_j=125^\circ C$ | | MIN | 0.2 | V |
| I_H | 维持电流 $I_T=0.5A$ | | MAX | 60 | mA |
| I_L | 擎住电流 $I_G=1.2I_{GT}$ | I | MAX | 60 | mA |
| dv/dt | 断态电压临界上升率 $V_D=2/3V_{DRM}$ $T_j=125^\circ C$ | | MIN | 500 | V/us |
| (dv/dt) _c | 换向电压临界上升率 $T_j=125^\circ C$ | | MIN | 10 | V/us |

●静态参数

| 符号 | 名称和测试条件 | | | 数值 | 单位 |
|------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----|------|--------------|
| V_{TM} | 通态峰值电压 $I_{TM}=75A$ | $T_j=25^\circ C$ | MAX | 1.5 | V |
| V_{T0} | 门槛电压 | $T_j=125^\circ C$ | MAX | 0.87 | V |
| R_d | 斜率电阻 | $T_j=125^\circ C$ | MAX | 14.6 | m Ω |
| I_{DRM} I_{RRM} | 断态峰值电流 反向峰值电流 | $T_j=25^\circ C$ $T_j=125^\circ C$ | MAX | 5 | μA |
| | | | | 1 | mA |
| $R_{th(j-c)}$ | 结壳热阻 | A | | 2.05 | $^\circ C/W$ |
| | | B | | 1.25 | |

● 电性曲线

FIG.1: Maximum power dissipation versus RMS on-state current

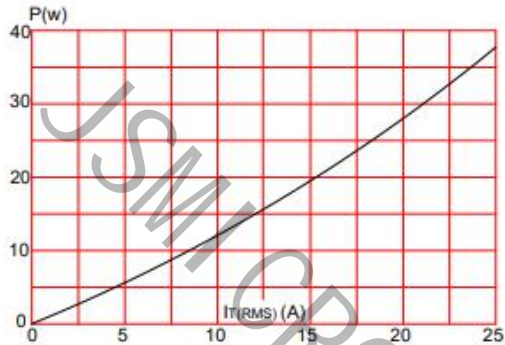


FIG.2: RMS on-state current versus case temperature

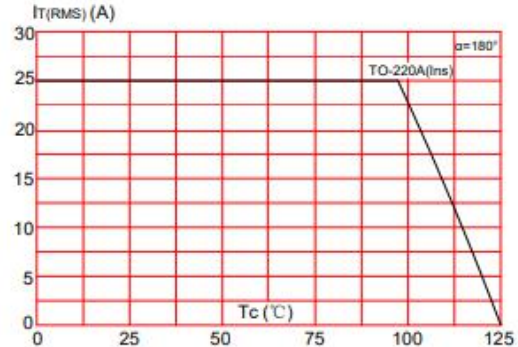


FIG.3: Surge peak on-state current versus number of cycles

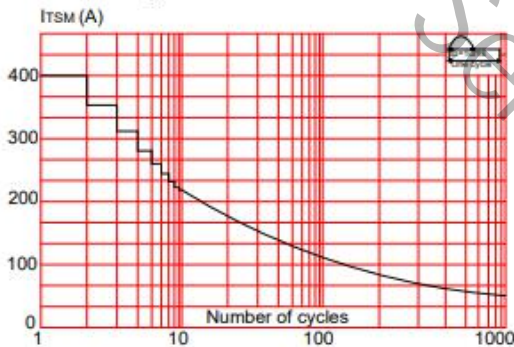


FIG.4: On-state characteristics (maximum values)

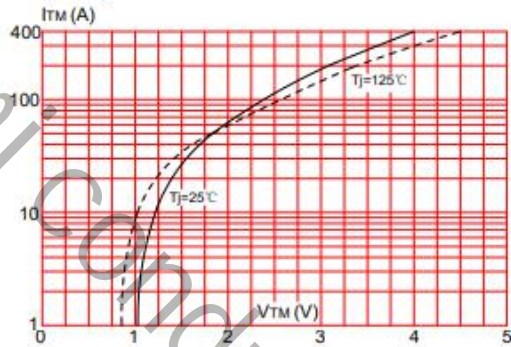


FIG.5: Non-repetitive surge peak on-state current for a sinusoidal pulse with width $t_p < 10\text{ms}$, and corresponding value of I^2t ($di/dt < 150\text{A}/\mu\text{s}$)

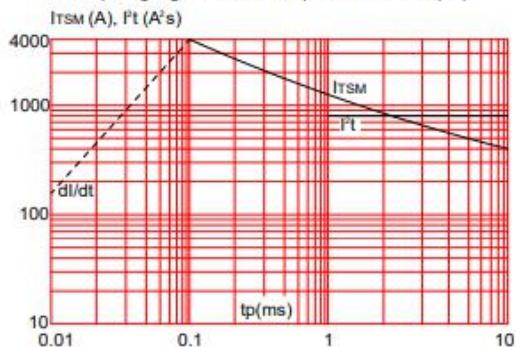
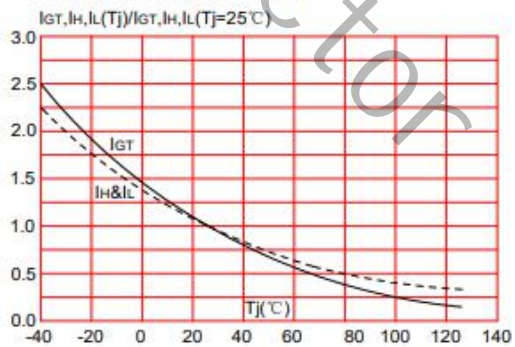


FIG.6: Relative variations of gate trigger current, holding current and latching current versus junction temperature



T0-220外形尺寸图:

